

**PNP POWER TRANSISTORS**  
**TRANSISTORS DE PUISSANCE PNP**

Complementary of 2N 3054, 2N 3055  
 Complémentaires des 2N 3054, 2N 3055

**TECHNOLOGICAL DATA**  
**DONNEES TECHNOLOGIQUES**

Material : Silicon  
 Structure : Epitaxial base

Matériau : Silicium  
 Structure : Base épitaxiée

- General purpose  
 Usage général
- LF Amplifier  
 Amplification basse fréquence

**ABSOLUTE RATINGS Limiting values (For encapsulated devices)**  
**VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION (En boîtier d'origine)**  $t_{amb} = 25^{\circ}C$  and configuration  
 et configuration

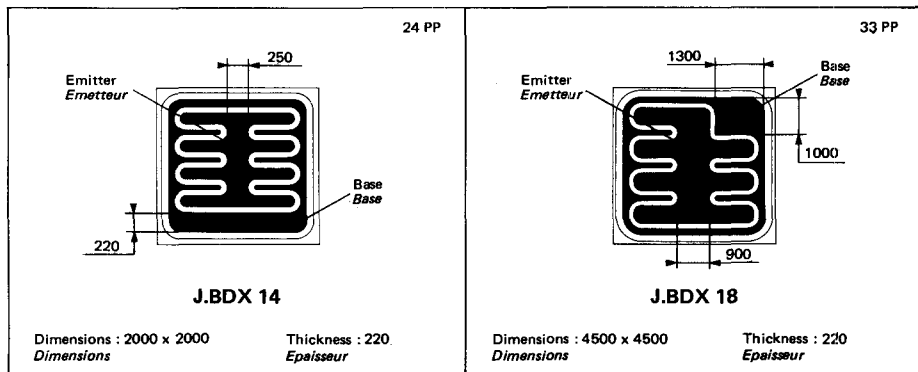
Type	P <sub>tot</sub> (W)	V <sub>CBO</sub> (V)	V <sub>CEO</sub> (V)	V <sub>CEX</sub> (V)	V <sub>EBO</sub> (V)	I <sub>C</sub> (A)	t <sub>stg</sub> (°C)		t <sub>j</sub> (°C)
							min.	max.	max.
J.BDX 14	29 (1)	-90	-55	-90	-7	-4	-65	+200	+200
J.BDX 18	117(2)	-100	-60	-90	-7	-15	-65	+200	+200

- (1) When mounted in TO-66 case,  $t_{case} = 25^{\circ}C$   
 Quand la pastille est montée en boîtier TO-66,  $t_{case} = 25^{\circ}C$
- (2) When mounted in TO-3 case,  $t_{case} = 25^{\circ}C$   
 Quand la pastille est montée en boîtier TO-3,  $t_{case} = 25^{\circ}C$

**MECHANICAL CHARACTERISTICS**  
**CARACTERISTIQUES MECANIQUES**

Front metallization : Aluminium (Base-emitter)  
 Back metallization : Gold, nickel (See page 60)  
 All dimensions in  $\mu m$

Métallisation face avant : Aluminium (Base-émetteur)  
 Métallisation face arrière : Or, nickel (Voir page 60)  
 Dimensions en  $\mu m$



**STATIC CHARACTERISTICS (Tested with contact probes)\***  
*CARACTERISTIQUES STATIQUES (Mesurées sous pointes)*

$t_{amb} = 25^{\circ}C$

Type	$V_{(BR)CEO} / I_C$		$V_{(BR)CER} / I_C / R_{BE}$			$V_{(BR)EBO} / I_E$		$I_{CEX} / V_{CE}$		$h_{21E} / I_C / V_{CE}$			
	(V)	(mA)	(V)	(mA)	( $\Omega$ )	(V)	(mA)	(mA)	(V)	min.		max.	
J.BDX 14	-55	-100	-60	-100	100	-7	-1	-1	-90	25	100	-0,5	-4
J.BDX 18	-60	-200	-70	-200	100			-5	-90	20	70	-4	-4

\*Pulsed  
*En impulsions*

**DYNAMIC CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)**  
*CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (En boîtier d'origine)*

$t_{amb} = 25^{\circ}C$

Type	$f_T / I_C / V_{CE}$		
	(MHz)	(A)	(V)
	min.		
J.BDX 14	0,8	-0,2	-10
J.BDX 18	0,8	-1	-10

**OTHER CHARACTERISTICS (For encapsulated devices)**  
*AUTRES CARACTERISTIQUES (En boîtier d'origine)*

$t_{amb} = 25^{\circ}C$

Type	$V_{BE} / I_C / V_{CE}$			$V_{CEsat} / I_C / I_B$			$I_{CEX} / V_{CE} / t_j$		
	(V)	(A)	(V)	(V)	(A)	(A)	(mA)	(V)	( $^{\circ}C$ )
	max.			max.			max.		
J.BDX 14	-1,7	-0,5	-4	-1	-0,5	-0,05	-5	-30	150
J.BDX 18	-1,8	-4	-4	-1,1	-4	-0,4	-10	-60	150

Acceptance requirements, inspection level and AQL : see General Information page 55 to 71  
*Conditions de contrôle, niveaux de prélevement et NQA : voir Informations Générales page 55 à 71*